

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.03.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы проектирования и технологии электронной компонентной базы
(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

направленность (профиль)
Робототехнические системы

Форма обучения: заочная

Год набора: 2022

Общая трудоемкость: 5 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Сессия	3	Итого
Форма контроля	экзамен	
Вид занятий		
Лекции	4	4
Лабораторные	6	6
Практические		
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	10,35	10,35
Самостоятельная работа	161	161
Контроль	8,65	8,65
Итого	180	180

Рабочую программу составил:

профессор, доцент, д.т.н Певчев В.П.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☒

Отсутствует

☐

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности)

11.03.04 Электроника и микроэлектроника

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры

Промышленная электроника

(протокол заседания № 1 от «01» сентября 2021 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – изучение студентами характеристик, параметров и основ проектирования и применения интегральных микросхем (ИМС).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника», профиль «Электроника и робототехника», к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Физика», «Электротехнические материалы», «Основы электронной техники», «Полупроводниковые приборы».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Электронные промышленные устройства; Основы микропроцессорной техники.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-5. Способен разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы	ИД-1 ПК-5 Знает принципы построения технического задания при разработке электронных блоков	Знать: основные требования ЕСКД на проектную и техническую документацию по аналоговым и цифровым электронным устройствам
	ИД-2ПК-5 Умеет использовать нормативные и справочные данные при разработке проектно-конструкторской документации	Уметь: создавать проектную и техническую документацию по аналоговым и цифровым электронным устройствам
	ИД-3ПК-5 Владеет навыками оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами	Владеть: практическими навыками работы с программными пакетами сквозного проектирования в электронике

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Сессия	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наимено- вание оценочного средства)
Модуль №1	Лек1	Лекция №1	3	2		-	
Модуль №2	Лаб1	Лабораторное занятие №1	3	2		-	
Модуль №1	Ср1	Самостоятельное изучение материала №1	3	8		-	
Модуль №1	Лек2	Лекция №2	3	2		-	
Модуль №2	Ср2	Самостоятельное изучение материала №2	3	8		-	
Модуль №2	Лаб1а	Лабораторное занятие № 1а	3	2		-	
Модуль №1	Лек3	Лекция №3	3	2		-	
Модуль №2	Лаб1б	Лабораторное занятие № 1б.	3	2		-	
Модуль №1	Лек4	Лекция №4	3	8		-	
Модуль №1	КР1	Контрольная работа по Модулю №1	3	2	10	-	Контрольная работа
Модуль №2	Ср3	Самостоятельное изучение материала №3	3	8		-	
Модуль №2	Лаб1в	Лабораторное занятие № 1в	3	2		-	
Модуль №2	Лек5	Лекция №5	3	2		-	
Модуль №2	Лаб1г	Лабораторное занятие № 1г	3	2		-	
Модуль №2	Лек6	Лекция №6	3	2		-	
Модуль №2	Лаб1д	Лабораторное занятие № 1д	3	2		-	
Модуль №2	Лек7	Лекция №7	3	2		-	
Модуль №2	Лаб1е	Лабораторное занятие № 1е	3	2		-	
Модуль №2	Лек8	Лекция №8	3	2		-	
Модуль №2	Лаб1ж	Лабораторное занятие № 1ж	3	2		-	
Модуль №2	Лек9	Лекция №9	3	2		-	
Модуль №3	Ср5	Самостоятельное изучение материала №4	3	8		-	
Модуль №2	Лаб1з	Лабораторное занятие № 1з	3	2	12	-	Лабораторная работа
Модуль №2	Лек10	Лекция №10	3	2		-	
Модуль №2	КР2	Контрольная работа по Модулю №2	3	0	10	-	Контрольная работа
Модуль №3	Ср3	Самостоятельное изучение материала №5	3	8		-	

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Сессия	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наимено- вание оценочного средства)
Модуль №3	Лаб2а	Лабораторное занятие № 2а	3	2		-	
Модуль №3	Лек11	Лекция №11	3	2		-	
Модуль №3	Лаб2б	Лабораторное занятие № 2б	3	2		-	
Модуль №3	Лек12	Лекция №12	3	2		-	
Модуль №3	Лаб2в	Лабораторное занятие № 2в	3	2		-	
Модуль №3	Лек13	Лекция №13	3	2		-	
Модуль №3	Лаб2г	Лабораторное занятие № 2г	3	2		-	
Модуль №4	Срб	Самостоятельное изучение материала №6	3	2		-	
Модуль №3	Лек14	Лекция №14	3	2		-	
Модуль №3	Лаб2д	Лабораторное занятие № 2д	3	2		-	
Модуль №3	Лек15	Лекция №15	3	0		-	
Модуль №3	КР3	Контрольная работа по Модулю №3	3	0	10	-	Контрольная работа
Модуль №3	Лаб2е	Лабораторное занятие № 2е	3	2		-	
Модуль №4	Лек16	Лекция №16	3	2		-	
Модуль №3	Лаб2ж	Лабораторное занятие № 2ж	3	2		-	
Модуль №4	Лек17	Лекция №17	3	0		-	
Модуль №4	КР4	Контрольная работа по Модулю №4	3	0	10	-	Контрольная работа
Модуль №3	Лаб2з	Лабораторное занятие № 2з	3	2	12	-	Лабораторная работа
	ПЭ	Подготовка к экзамену		56		-	Вопросы к экзамену №1-60
	ТИ	Итоговый тест по курсу через ОТ		10	100		
Итого:				180			

Схема расчета итогового балла стандартная: полусумма результата теста, проводимого через ОТ, и баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в курсе.

5. Образовательные технологии

На лекционных занятиях используется традиционная образовательная технология в виде чтения лекций.

Консультации по курсовой работе проводятся в интерактивной форме - в виде проблемных семинаров.

При выполнении и защите лабораторных работ применяется технология критического мышления, при которой студенты проверяют и анализируют полученную информацию в ходе сравнения экспериментальных данных с полученными компьютерным моделированием.

6. Методические указания по освоению дисциплины

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Сессия	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
3	ПК-5	Контрольная работа №3 Проект Вопросы к экзамену №1,28,40-60

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Контрольные работы

Тема 1 Технологические процессы интегральной электронной компонентной базы

- 1 Показатели технологичности микросхем.
- 2 Способы электрической изоляции элементов полупроводниковых ИМС
- 3 Технология изготовления биполярных NPN- транзисторов ИМС.
- 4 Технология изготовления PNP- транзисторов ИМС.
- 5 Технология изготовления ИМС с транзисторами Шоттки.
- 6 Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: р-п- переходом, диэлектриком, переходом металл - полупроводник
- 7 Электрическая изоляция элементов полупроводниковых ИМС диффузией к подложке обратнсмещённым переходом
- 8 Электрическая изоляция элементов полупроводниковых ИМС диффузией к коллектору
- 9 Способы электрической изоляции элементов полупроводниковых ИМС диэлектриком
- 10 Технологическая операция высокотемпературной эпитаксии
- 11 Технологическая операция диффузии
- 12 Технологическая операция ионного легирования
- 13 Технологическая операция молекулярно-лучевой эпитаксии
- 14 Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: р-п- переходом
- 15 Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: диэлектриком
- 16 Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: переходом металл - полупроводник
- 17 Электрическая комбинированная изоляция элементов полупроводниковых микросхем диэлектриком и обратнсмещённым р-п- переходом.

Тема 2 Основы проектирования микросхем. Технология РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, ЭСЛ, ИИЛ, МОП, КМОП и МЕР логики базы

- 1 Технология изготовления базовых элементов РТЛ.
- 2 Технология изготовления базовых элементов ДТЛ.

- 3 Технология изготовления базовых элементов высокопороговой ДТЛ.
- 4 Технология изготовления базовых элементов малосигнальной ТТЛ
- 5 Технология изготовления базовых элементов ТТЛШ.
- 6 Технология изготовления базовых элементов ЭСЛ для ИМС
- 7 Технология изготовления базовых элементов малосигнальной ЭСЛ .
- 8 Технология изготовления базовых элементов n-МОП логики.
- 9 Технология изготовления базовых элементов логики с инжекционным питанием.
- 10 Технология изготовления базовых элементов КМОП логики.
- 11 Технология изготовления базовых элементов MeП логики.

Тема 3 Схемотехника каскадов усиления напряжения, входных и выходных каскадов, источников тока, преобразователей уровня напряжения

- 1 Основные характеристики и параметры аналоговых ИМС.
- 2 Схемотехника входных каскадов аналоговых ИМС (дифференциальные усилители).
- 3 Схемотехника выходных каскадов аналоговых ИМС (однотактные и двухтактные).
- 4 Схемотехника преобразователей уровня напряжения и источников тока.
- 5 Схемотехника каскадов усиления напряжения в аналоговых ИМС, коррекция АЧХ.
- 6 Схемотехника однотактных выходных каскадов аналоговых ИМС
- 7 Схемотехника двухтактных выходных каскадов аналоговых ИМС
- 8 Схемотехника преобразователей уровня напряжения
- 9 Схемотехника источников тока в ИМС
- 10 Полная коррекция АЧХ. усилителя
- 11 Частичная коррекция АЧХ. усилителя
- 12 Эффект расщепления фаз

Тема 4 Основы функциональной электроники

- 1 Структура и принцип действия приборов с зарядовой связью.
- 2 Структура и принцип действия приборов на поверхностных акустических волнах.
- 3 Структура и принцип действия приборов на цилиндрических магнитных доменах
- 4 Функциональные схемы и классификация микросхем памяти.
- 5 Ячейки микросхем памяти динамического типа (ОЗУ, ПЗУ).
- 6 Ячейки микросхем памяти статического типа (СОЗУ) на биполярных транзисторах.
- 7 Ячейки микросхем памяти статического типа (СОЗУ) на полевых транзисторах.

По истечении одного учебного часа подготовки студент сдаёт письменный ответ по заданному ему варианту

Критерии оценки:

Оценка «10 баллов» выставляется студенту, если в письменном ответе не содержится ни одной ошибки. Каждая ошибка снижает итоговый балл контрольной работы на единицу.

Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Курсовая работа «Разработка усилителя переменного тока». Разновидности: УНЧ, УВЧ, полосовой, режекторный

7.2.2. Лабораторные работы:

Лабораторная работа №1 «Масштабируемые усилители»

Отчёты по лабораторной работе оформляются в соответствии с ЕСКД и принятыми на кафедре требованиями к оформлению отчётов

1. Титульный лист с указанием номера группы и ФИО студента и преподавателя;
2. Цель работы;
3. Программа проводимых испытаний;
4. Схемы исследуемых устройств (схем);
5. Таблицы с экспериментальными данными;

6. Графики, построенные по экспериментальным данным и осциллограммы сигналов;
7. Выводы по результатам исследований.
8. Список использованной литературы.

Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Запишите выражения, по которым определяются коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления инвертирующего и неинвертирующего усилителей.
2. Допущения, принимаемые при анализе масштабируемых усилителей.
3. Вид АЧХ масштабируемого усилителя, ОУ.
4. Какие факторы влияют на снижение коэффициента усиления в области низких и высоких частот?
5. Как ООС влияет на полосу пропускания масштабного усилителя? Почему так?
6. Назначение элементов использованных в работе схем.

Лабораторная работа №2 «Исследование микросхем транзисторно - транзисторной логики»

Отчёты по лабораторной работе оформляются в соответствии с ЕСКД и принятыми на кафедре требованиями к оформлению отчётов

1. Титульный лист с указанием номера группы и ФИО студента и преподавателя;
2. Цель работы;
3. Программа проводимых испытаний;
4. Схемы исследуемых устройств (схем);
5. Таблицы с экспериментальными данными;
6. Графики, построенные по экспериментальным данным и осциллограммы сигналов;
7. Выводы по результатам исследований.
8. Список использованной литературы.

Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Зарисовать схему инвертора ТТЛ 155 серии и объяснить назначение элементов схемы R1, R2, R3, R4, VD.
2. Указать режимы работы транзисторов схемы при любом напряжении на входе в диапазоне 0 — E.
3. Объяснить вид входной, передаточной и выходных характеристик логических элементов 155 серии.
4. На какие параметры логических элементов и как влияет величина сопротивления резистора R3.

Процедура оценивания лабораторных работ № 1 и 2

Вопросы для защиты лабораторных работ приведены в методическом пособии. Лабораторная работа считается зачтённой при условии выполнения указанных в пособии разделов, правильности экспериментальных и полученных компьютерным моделированием данных, а также правильных ответов на вопросы по теории, соответствующие теме лабораторной работы. В случае неправильных ответов защита отчёта повторяется. Количество повторов ограничено лишь временем лабораторных занятий.

Критерии оценки:

Оценка «12 баллов» выставляется студенту при условии выполнения указанных в пособии разделов, правильности полученных данных, а также если даны правильные ответы на вопросы по теории, соответствующие теме лабораторной работы (два вопроса). Если не даны правильные ответы на вопросы по теории, соответствующие теме лабораторной работы защита отчёта может быть повторена со снижением оценки на 1 балл (в итоге не менее 2).

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Сессия 3

№ п/п	Вопросы к экзамену
1	Показатели технологичности микросхем.
2	Способы электрической изоляции элементов полупроводниковых ИМС
3	Технология изготовления биполярных NPN- транзисторов ИМС.
4	Технология изготовления PNP- транзисторов ИМС.
5	Технология изготовления ИМС с транзисторами Шоттки.
6	Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: р-п-переходом, диэлектриком, переходом металл - полупроводник
7	Электрическая изоляция элементов полупроводниковых ИМС диффузией к подложке обрат-носмещённым переходом
8	Электрическая изоляция элементов полупроводниковых ИМС диффузией к коллектору
9	Способы электрической изоляции элементов полупроводниковых ИМС диэлектриком
10	Технологическая операция высокотемпературной эпитаксии
11	Технологическая операция диффузии
12	Технологическая операция ионного легирования
13	Технологическая операция молекулярно-лучевой эпитаксии
14	Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: р-п-переходом
15	Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: ди-электриком
16	Технология изготовления полевых транзисторов с затвором, изолированным от канала: пере-ходом металл - полупроводник
17	Технология изготовления базовых элементов РТЛ.
18	Технология изготовления базовых элементов ДТЛ.
19	Технология изготовления базовых элементов высокопороговой ДТЛ.
20	Технология изготовления базовых элементов малосигнальной ТТЛ
21	Технология изготовления базовых элементов ТТЛШ.
22	Технология изготовления базовых элементов ЭСЛ для ИМС
23	Технология изготовления базовых элементов малосигнальной ЭСЛ .
24	Технология изготовления базовых элементов n-МОП логики.
25	Технология изготовления базовых элементов логики с инжекционным питанием.
26	Технология изготовления базовых элементов КМОП логики.
27	Технология изготовления базовых элементов MeП логики.
28	Основные характеристики и параметры аналоговых ИМС.
29	Схемотехника входных каскадов аналоговых ИМС (дифференциальные усилители).
30	Схемотехника выходных каскадов аналоговых ИМС (однотактные и двухтактные).
31	Схемотехника преобразователей уровня напряжения и источников тока.
32	Схемотехника каскадов усиления напряжения в аналоговых ИМС, коррекция АЧХ.
33	Схемотехника однотактных выходных каскадов аналоговых ИМС
34	Схемотехника двухтактных выходных каскадов аналоговых ИМС
35	Схемотехника преобразователей уровня напряжения
36	Схемотехника источников тока в ИМС
37	Полная коррекция АЧХ. усилителя
38	Частичная коррекция АЧХ. усилителя
39	Эффект расщепления фаз
40	Характеристики и параметры логических ИМС.
41	Схемотехника изготовления базовых элементов РТЛ.
42	Схемотехника базовых элементов ДТЛ.

№ п/п	Вопросы к экзамену
43	Схемотехника базовых элементов высокопороговой ДТЛ.
44	Схемотехника базовых элементов малосигнальной ТТЛ
45	Схемотехника базовых элементов ТТЛШ.
46	Схемотехника базовых элементов ЭСЛ для ИМС
47	Схемотехника базовых элементов малосигнальной ЭСЛ .
48	Схемотехника базовых элементов n-МОП логики.
49	Схемотехника базовых элементов логики с инжекционным питанием.
50	Схемотехника базовых элементов КМОП логики.
51	Схемотехника базовых элементов MeП логики.
52	Схемотехника базовых элементов ТТЛ малой степени интеграции
53	Схемотехника базовых элементов p-МОП логики.
54	Структура и принцип действия приборов с зарядовой связью.
55	Структура и принцип действия приборов на поверхностных акустических волнах.
56	Структура и принцип действия приборов на цилиндрических магнитных доменах
57	Функциональные схемы и классификация микросхем памяти.
58	Ячейки микросхем памяти динамического типа (ОЗУ, ПЗУ).
59	Ячейки микросхем памяти статического типа (СОЗУ) на биполярных транзисторах.
60	Ячейки микросхем памяти статического типа (СОЗУ) на полевых транзисторах.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Сессия	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
3	экзамен	«отлично»	Студент набрал 85- 100 баллов по итогу изучения дисциплины в семестре.
		«хорошо»	Студент набрал 70- 84 баллов по итогу изучения дисциплины в семестре.
		«удовлетворительно»	Студент набрал 55- 69 баллов по итогу изучения дисциплины в семестре.
		«неудовлетворительно»	Студент набрал 0-54 баллов по итогу изучения дисциплины в семестре

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Ефимов И.Е., Козырь И.Я.	Основы микроэлектроники	учебник	2016	1
2	Жданова Н.В	Микроэлектроника	лаб.практикум	2014	ЭБС «IPRbooks»
3	Титце У, Шенк К.	Полупроводниковая схемотехника. Том I	учеб. пособие	2017	ЭБС «IPRbooks»
4	Титце У, Шенк К.	Полупроводниковая схемотехника. Том II	учеб. пособие	2017	ЭБС «IPRbooks»

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Смирнов Ю. А.	Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники	учеб. пособие	2013	ЭБС «Лань»
2	А.А. Коваленко, М.Д. Петропавловский.	Основы микроэлектроники	учеб. пособие	2006	11
3	Аваев Н.А.: для радиотехн. спец. вузов / Н.А. Аваев, Ю.Е. Наумов, В.Т. Фролкин. - М.	Основы микроэлектроники	учеб. пособие	1981	70

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- Журнал «Силовая электроника» [Электронный ресурс] : науч. журн. / — Электрон. журн. — Москва, Санкт-Петербург. — Режим доступа к журн.: <http://power-e.ru/>
- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. — Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . — Режим доступа : apps.webofknowledge.com. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. — Netherlands: Elsevier, 2004– . — Режим доступа : scopus.com. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. — Москва : НЭБ, 2000– . — Режим доступа : elibrary.ru. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
	Студенческая версия программы Micro-CAP 12	freeware, бессрочно
	Программа Pclab2000	бессрочно

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Э- 405 Аудитория веб-конференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации	Стол преподавательский, экран телевизионный, роутер, стойка для телевизора, веб.камера, транспарант-перетяжка, ширма,наушники, компьютер с выходом в Интернет.
2	Г-401 Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Столы, стулья, компьютеры
3	Э-407 Аудитория веб-конференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения заня-	Стол преподавательский, экран телевизионный, роутер, стойка для телевизора, веб.камера, транспарант-перетяжка, ширма,наушники, компьютер с выходом в Интернет, хромакей

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	<p>тий семинарского типа.</p> <p>Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ).</p> <p>Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций.</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	